



Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного
применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Диода Тип DR100-3200-65

Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾		I _{FAV}	3200 A
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U _{RRM}	6200...6500 В
U _{RRM} , В	6200	6400	6500
Класс по напряжению	62	64	65
T _я , °C	-60...+150		

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

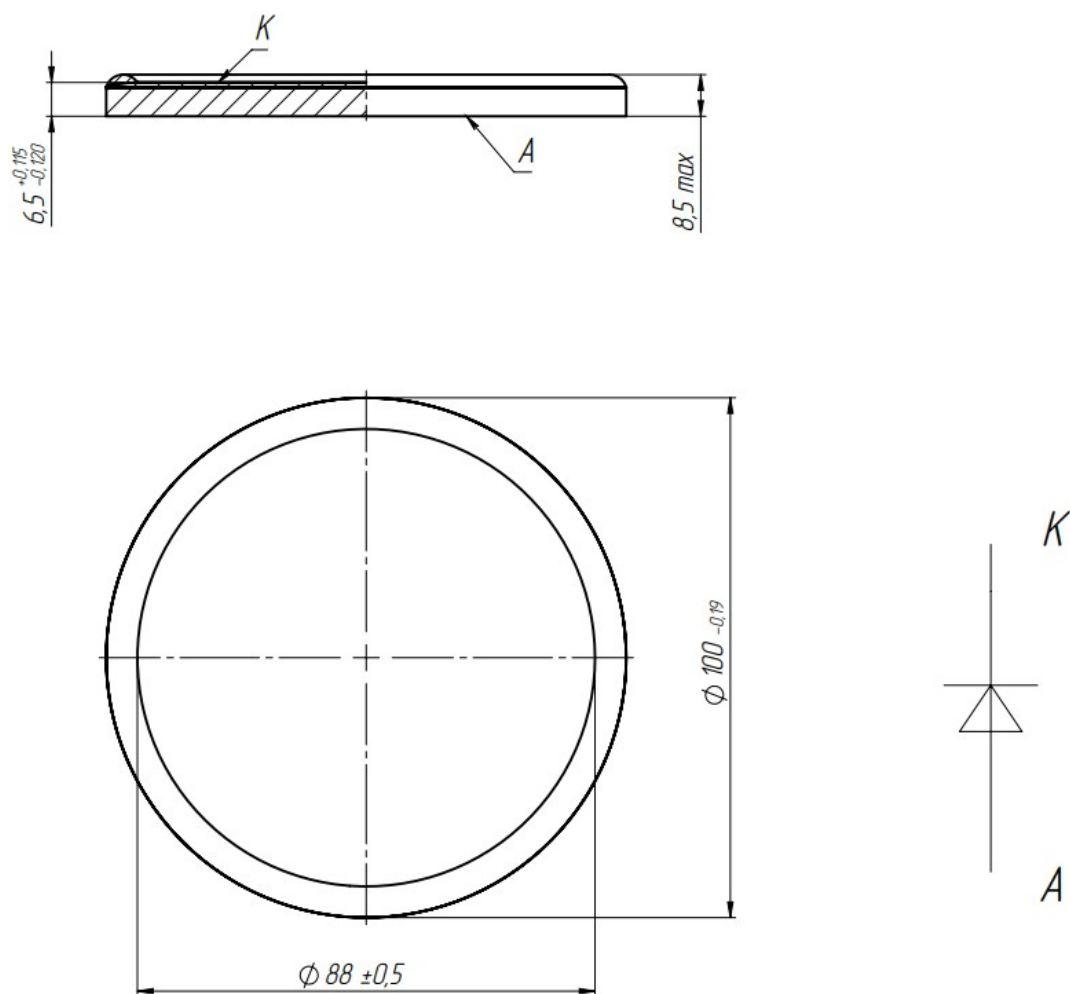
Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I _{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾	A	3200 3750	T _c =111 °C; двухстороннее охлаждение; T _c =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FRMS}	Действующий прямой ток ¹⁾	A	5024	T _c =111 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FSM}	Ударный ток ¹⁾	кА	64.0 74.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
			67.0 77.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
I ² t	Защитный показатель ¹⁾	A ² с10 ³	20400 27300	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
			18600 24600	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
Блокирующие параметры					
U _{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	6200...6500	T _{j min} < T _j < T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U _{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	6300...6600	T _{j min} < T _j < T _{j max} ; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U _R	Постоянное обратное напряжение	В	0.6·U _{RRM}	T _j =T _{j max}	
Тепловые параметры					
T _{stg}	Температура хранения	°C	−60...+55		
T _j	Температура р-п перехода	°C	−60...+150		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие ¹⁾	кН	70.0...90.0		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение ¹⁾ , макс	В	1.85	T _j =25 °C; I _{FM} =6300 А	
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	0.90	T _j =T _{j max} ; 0.5 π I _{FAV} < I _T < 1.5 π I _{FAV}	
r _T	Динамическое сопротивление ¹⁾ , макс	МОм	0.190		
Блокирующие характеристики					
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	300	T _j =T _{j max} ; U _R =U _{RRM}	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус ¹⁾ , макс	°C/Вт	0.0050	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.0150		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.0075		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	497		

МАРКИРОВКА		ПРИМЕЧАНИЕ
DR 100 3200 65 1 2 3 4 1. ППЭ Низкочастотного Диода 2. Максимальный диаметр, мм 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению		¹⁾ В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс D.G1.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.